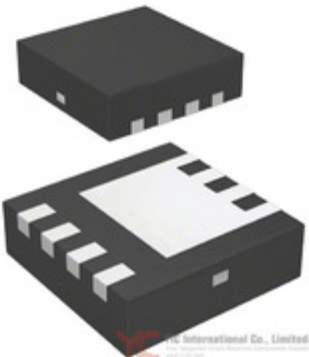








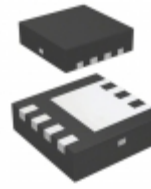
	<h2 style="color: #D9534F;">SISS10DN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SISS10DN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 60A PPAK 1212-8S
	Datenblätter:  SISS10DN-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 15075 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SISS10DN-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 60A PPAK 1212-8S
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	15075 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8S (3.3x3.3)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.65 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	57W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3750pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	75nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SISS10DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SISS10DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SISS10DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SISS10DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SISS23DN-T1-E3 VISHAY VISHAY PAK1212</p>	 <p>SISS23DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 50A PPAK 1212-8S</p>	 <p>SISS10DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A PPAK 1212-8S</p>	 <p>SISS23DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 50A PPAK 1212-8S</p>
 <p>SISM672A1BD SIS SIS BGAPB</p>	 <p>SISNAP915DK Silicon Labs RF EVAL 915MHZ SYNAPSE DEV KIT</p>	 <p>SISNAP915EK Silicon Labs RF EVAL 915MHZ MODULE ANTENNA</p>	 <p>SISS02DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 25V POWERPAK 1212-</p>

SISS10DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

Vishay / Siliconix	SISS10DN-T1-GE3 Datenblatt	SISS10DN-T1-GE3-Datenblätter	SISS10DN-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SISS10DN-T1-GE3
SISS10DN-T1-GE3 Electronic	SISS10DN-T1-GE3-Komponenten	SISS10DN-T1-GE3-Verteiler	SISS10DN-T1-GE3-Bild	SISS10DN-T1-GE3-Teil
SISS10DN-T1-GE3 Preis	SISS10DN-T1-GE3 Hersteller	SISS10DN-T1-GE3 Bild	SISS10DN-T1-GE3 Aktie	SISS10DN-T1-GE3 Inventar
SISS10DN-T1-GE3 Neu	SISS10DN-T1-GE3 Original	SISS10DN-T1-GE3 garantiert	SISS10DN-T1-GE3 RFQ	SISS10DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited